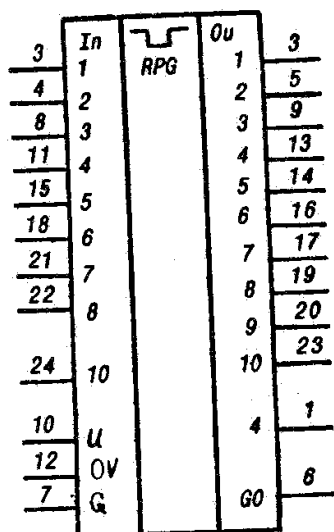


# К1030ХК1



Микросхема представляет собой схему для имплантируемых мультипрограммируемых электрокардиостимуляторов. Содержит 4000 интегральных элементов. Корпус типа 4204.24-1, масса не более 2 г.

## Назначение выводов

1 — вторичное напряжение питания; 2 — выход схемы VARIO-функции; 3 — вход 1 схемы VARIO-функции; 4 — вход 2 схемы VARIO-функции; 5 — контрольная частота кв/8; 6 — выход кварцевого генератора; 7 — вход кварцевого генератора; 8 — вход тока смещения; 9 — вольтодобавочный конденсатор; 10 — первичное напряжение питания; 11 — вход усилителя 2; 12 — общий; 13 — выход усилителя 2; 14 — выход усилителя 1; 15 — вход усилителя 1; 16 — конденсатор фильтрующий; 17 — выход 2 усилителя 1; 18 — вход вольтодобавочного конденсатора; 19 — выход 1 на нагрузку; 20 — выход 2 на нагрузку; 21 — вход приемника кодов; 22 — вход внешней синхронизации; 23 — выход импульса рефрактерности; 24 — вход/ выход схемы ограничения частоты.

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	$3 \text{ В} \pm 10\%$
Ток потребления	$< 10 \text{ мкА}$
Амплитуда импульса стимуляции на выходе при $R_n = (510 \pm 1\%) \text{ Ом}$ , режим программирования для $s = 1; 2; 4$	$(2,5-0,25)c \dots 2,5 c \dots (2,5 + 0,25)c \text{ В}$
Длительность импульса стимуляции на входе (режим программирования для $n = 14$ )	$(250n-50) \dots 250n \dots (250n+50) \text{ мкс}$
Частота следования импульсов стимуляции (режим программирования для $m = 0; 2; 4 \dots 22$ )	$27 + 5m \dots 30 + 5m \dots 33 + 5m \text{ имп/мин}$
Гистерезис периода следования импульсов стимуляции (режим программирования для $k = 0; 1; 2; 3$ )	$(125k-25) \dots 125k \dots (125k+25) \text{ мс}$
Рефрактерный период (зона нечувствительности КР+ и Т+ волне): режим программирования для $z = 0,1$	$62z+225 \dots 62z+250 \dots 62z+275 \text{ мс}$
для $z = 3$	$62z+226 \dots 62z+251 \dots 62z+276 \text{ мс}$

Чувствительность (порог чувствительности) к Р+ волне (тестовый сигнал)  $< 10 \text{ мВ}$

*Примечания. Форма тестового сигнала и методика контроля электрических параметров микросхемы приведены в ГОСТ 24062-80.*

*Конкретное значение коэффициентов  $s, m, n, k, z$  выбирается двенадцатизрядным цифровым кодом с внешнего программатора.*

*Все параметры приводятся при конкретном значении режимного резистора  $R_{nodst}$ , выбираемом при регулировании из ряда E24 в диапазоне 6,2...62 МОм.*

## Предельно допустимые режимы эксплуатации

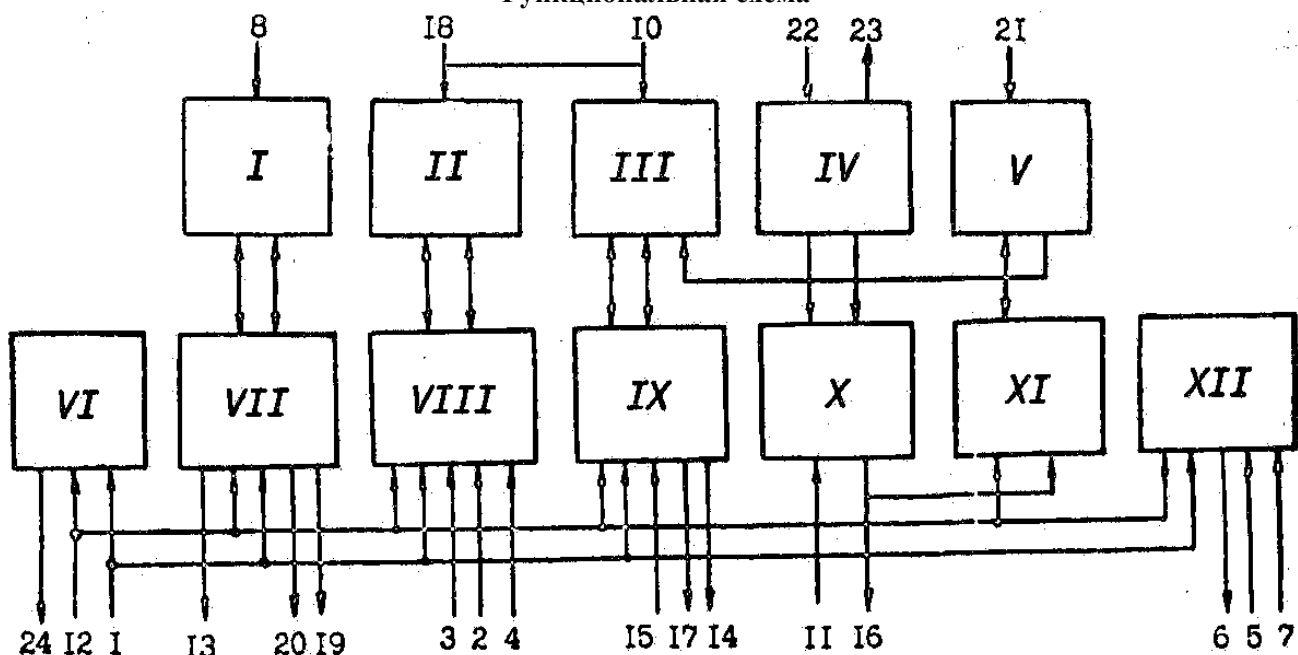
Напряжение источника питания	$2,7 \dots 3,3 \text{ В}$
Сопротивление нагрузки	$> 500 \text{ Ом}$
Температура окружающей среды	$-10 \dots +70 \text{ }^\circ\text{C}$

## Рекомендации по применению

Режим и условия монтажа в аппаратуре по ОСТ 11.073.063-84. Температура пайки не более  $265 \text{ }^\circ\text{C}$ , продолжительность пайки 4 с.

Контактирование микросхем в схемах производить при отключенном напряжении питания. Рекомендуется начинать пайку с выводов питания 10, 12, затем паять выводы усилителей 11, 13...15, 17, а остальные выводы в любой последовательности.

Функциональная схема



I — блок формирования опорного напряжения; II — блок удвоителей напряжения; III — блок контроля разряда батареи; IV — блок управляющей логики; V — накопитель данных; VI — блок ограничения частоты; VII — выходной каскад; VIII — блок формирования диагностической (АРО) функции; IX — усилитель 1; X — усилитель 2; XI — детектор; XII — кварцевый генератор.